

15.02.2005

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日            2 0 0 4 年   1 月   6 日  
Date of Application:

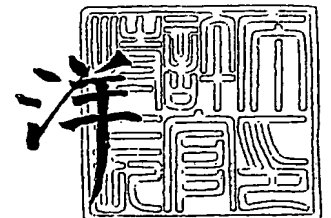
出 願 番 号            特 願 2 0 0 4 - 0 0 1 0 0 6  
Application Number:  
[ST. 10/C]:            [ J P 2 0 0 4 - 0 0 1 0 0 6 ]

出   願   人            日 新 イ オ ン 機 器 株 式 有 限 公 司  
Applicant(s):

2 0 0 5 年   3 月 2 4 日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

小 川



【書類名】 特許願  
【整理番号】 P03011  
【提出日】 平成16年 1月 6日  
【あて先】 特許庁長官殿  
【国際特許分類】 G21K 5/04  
H01J 37/317  
H01L 21/265

【発明者】  
【住所又は居所】 京都府京都市南区久世殿城町 5 7 5 番地 日新イオン機器株式会  
社内  
【氏名】 海勢頭 聖

【発明者】  
【住所又は居所】 京都府京都市南区久世殿城町 5 7 5 番地 日新イオン機器株式会  
社内  
【氏名】 濱本 成顕

【特許出願人】  
【識別番号】 302054866  
【氏名又は名称】 日新イオン機器株式会社  
【代表者】 辻 貞夫

【代理人】  
【識別番号】 100088661  
【弁理士】  
【氏名又は名称】 山本 恵二

【手数料の表示】  
【予納台帳番号】 003322  
【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】  
【物件名】 特許請求の範囲 1  
【物件名】 明細書 1  
【物件名】 図面 1  
【物件名】 要約書 1  
【包括委任状番号】 0213612

## 【書類名】特許請求の範囲

## 【請求項 1】

イオンビームを x 方向に平行走査してターゲットに照射する装置であって、当該イオンビームのビーム電流を計測する複数の検出器が前記 x 方向にそれぞれ並設されて成る前段多点ファラデーおよび後段多点ファラデーをターゲットの上流側および下流側にそれぞれ有しているイオン注入装置において、

前記前段多点ファラデーの上流側近傍に設けられていて前記イオンビームを遮ることができるものであって前記 x 方向に平行な一辺を有する前段ビーム制限シャッターと、

この前段ビーム制限シャッターを前記 x 方向と直交する y 方向に駆動する前段シャッター駆動装置と、

前記後段多点ファラデーの上流側近傍に設けられていて前記イオンビームを遮ることができるものであって前記 x 方向に平行な一辺を有する後段ビーム制限シャッターと、

この後段ビーム制限シャッターを前記 y 方向に駆動する後段シャッター駆動装置とを設けておき、

前記前段シャッター駆動装置によって前記前段ビーム制限シャッターを前記 y 方向に駆動しつつ、当該前段ビーム制限シャッターの前記一辺の外側を通過して前記前段多点ファラデーに入射するイオンビームのビーム電流の変化を計測して、前記前段ビーム制限シャッターの位置での前記イオンビームの前記 y 方向のビーム電流密度分布を求める前段ビーム電流密度分布計測工程と、

この前段ビーム電流密度分布計測工程で求めたビーム電流密度分布から、前記前段ビーム制限シャッターの位置での前記イオンビームの前記 y 方向の中心位置  $y_{cf}$  を求める前段中心位置算出工程と、

前記後段シャッター駆動装置によって前記後段ビーム制限シャッターを前記 y 方向に駆動しつつ、当該後段ビーム制限シャッターの前記一辺の外側を通過して前記後段多点ファラデーに入射するイオンビームのビーム電流の変化を計測して、前記後段ビーム制限シャッターの位置での前記イオンビームの前記 y 方向のビーム電流密度分布を求める後段ビーム電流密度分布計測工程と、

この後段ビーム電流密度分布計測工程で求めたビーム電流密度分布から、前記後段ビーム制限シャッターの位置での前記イオンビームの前記 y 方向の中心位置  $y_{cb}$  を求める後段中心位置算出工程と、

前記前段中心位置算出工程で求めた前記中心位置  $y_{cf}$ 、前記後段中心位置算出工程で求めた前記中心位置  $y_{cb}$  および前記前段ビーム制限シャッターと前記後段ビーム制限シャッターとの間の距離  $L$  を用いて、次式またはそれと数学的に等価な式に基づいて、前記イオンビームの前記 y 方向における角度偏差  $\theta_y$  を求める角度偏差算出工程とを行うことを特徴とするイオンビーム計測方法。

$$\theta_y = \tan^{-1} \{ (y_{cb} - y_{cf}) / L \}$$

## 【請求項 2】

イオンビームを x 方向に平行走査してターゲットに照射する装置であって、当該イオンビームのビーム電流を計測する複数の検出器が前記 x 方向にそれぞれ並設されて成る前段多点ファラデーおよび後段多点ファラデーをターゲットの上流側および下流側にそれぞれ有しているイオン注入装置において、

前記前段多点ファラデーの上流側近傍に設けられていて前記イオンビームを遮ることができるものであって前記 x 方向に平行な一辺を有する前段ビーム制限シャッターと、

この前段ビーム制限シャッターを前記 x 方向と直交する y 方向に駆動する前段シャッター駆動装置と、

前記後段多点ファラデーの上流側近傍に設けられていて前記イオンビームを遮ることができるものであって前記 x 方向に平行な一辺を有する後段ビーム制限シャッターと、

この後段ビーム制限シャッターを前記 y 方向に駆動する後段シャッター駆動装置とを設けておき、

前記前段シャッター駆動装置によって前記前段ビーム制限シャッターを前記 y 方向に駆

動しつつ、当該前段ビーム制限シャッターの前記一辺の外側を通過して前記前段多点ファラデーに入射するイオンビームのビーム電流の変化を計測して、前記前段ビーム制限シャッターの位置での前記イオンビームの前記 y 方向のビーム電流密度分布を求める前段ビーム電流密度分布計測工程と、

この前段ビーム電流密度分布計測工程で求めたビーム電流密度分布から、前記前段ビーム制限シャッターの位置での前記イオンビームの前記 y 方向のビームサイズ  $d_{yf}$  を求める前段ビームサイズ算出工程と、

前記後段シャッター駆動装置によって前記後段ビーム制限シャッターを前記 y 方向に駆動しつつ、当該後段ビーム制限シャッターの前記一辺の外側を通過して前記後段多点ファラデーに入射するイオンビームのビーム電流の変化を計測して、前記後段ビーム制限シャッターの位置での前記イオンビームの前記 y 方向のビーム電流密度分布を求める後段ビーム電流密度分布計測工程と、

この後段ビーム電流密度分布計測工程で求めたビーム電流密度分布から、前記後段ビーム制限シャッターの位置での前記イオンビームの前記 y 方向のビームサイズ  $d_{yb}$  を求める後段ビームサイズ算出工程と、

前記前段ビームサイズ算出工程で求めた前記ビームサイズ  $d_{yf}$ 、前記後段ビームサイズ算出工程で求めた前記ビームサイズ  $d_{yb}$  および前記前段ビーム制限シャッターと前記後段ビーム制限シャッターとの間の距離  $L$  を用いて、次式またはそれと数学的に等価な式に基づいて、前記イオンビームの前記 y 方向における発散角  $\alpha_{\max}$  を求める発散角算出工程とを行うことを特徴とするイオンビーム計測方法。

$$\alpha_{\max} = \tan^{-1} \{ (d_{yb} - d_{yf}) / 2L \}$$

### 【請求項 3】

イオンビームを x 方向に平行走査してターゲットに照射する装置であって、当該イオンビームのビーム電流を計測する複数の検出器が前記 x 方向にそれぞれ並設されて成る前段多点ファラデーおよび後段多点ファラデーをターゲットの上流側および下流側にそれぞれ有しているイオン注入装置において、

前記前段多点ファラデーの上流側近傍に設けられていて前記イオンビームを遮ることができるものであって前記 x 方向に平行な一辺を有する前段ビーム制限シャッターと、

この前段ビーム制限シャッターを前記 x 方向と直交する y 方向に駆動する前段シャッター駆動装置と、

前記後段多点ファラデーの上流側近傍に設けられていて前記イオンビームを遮ることができるものであって前記 x 方向に平行な一辺を有する後段ビーム制限シャッターと、

この後段ビーム制限シャッターを前記 y 方向に駆動する後段シャッター駆動装置とを設けておき、

前記前段シャッター駆動装置によって前記前段ビーム制限シャッターを前記 y 方向に駆動しつつ、当該前段ビーム制限シャッターの前記一辺の外側を通過して前記前段多点ファラデーに入射するイオンビームのビーム電流の変化を計測して、前記前段ビーム制限シャッターの位置での前記イオンビームの前記 y 方向のビーム電流密度分布を求める前段ビーム電流密度分布計測工程と、

この前段ビーム電流密度分布計測工程で求めたビーム電流密度分布から、前記前段ビーム制限シャッターの位置での前記イオンビームの前記 y 方向のビームサイズ  $d_{yf}$  を求める前段ビームサイズ算出工程と、

前記後段シャッター駆動装置によって前記後段ビーム制限シャッターを前記 y 方向に駆動しつつ、当該後段ビーム制限シャッターの前記一辺の外側を通過して前記後段多点ファラデーに入射するイオンビームのビーム電流の変化を計測して、前記後段ビーム制限シャッターの位置での前記イオンビームの前記 y 方向のビーム電流密度分布を求める後段ビーム電流密度分布計測工程と、

この後段ビーム電流密度分布計測工程で求めたビーム電流密度分布から、前記後段ビーム制限シャッターの位置での前記イオンビームの前記 y 方向のビームサイズ  $d_{yb}$  を求める後段ビームサイズ算出工程と、

前記前段ビームサイズ算出工程で求めた前記ビームサイズ  $d_{yf}$ 、前記後段ビームサイズ算出工程で求めた前記ビームサイズ  $d_{yb}$ 、前記前段ビーム制限シャッターと前記後段ビーム制限シャッターとの間の距離  $L$ 、前記前段ビーム制限シャッターと前記ターゲットとの間の距離  $L_1$  および前記ターゲットと前記後段ビーム制限シャッターとの間の距離  $L_2$  を用いて、次式またはそれと数学的に等価な式に基づいて、前記ターゲット上でのイオンビームの前記  $y$  方向におけるビームサイズ  $d_{yt}$  を求めるビームサイズ算出工程とを行うことを特徴とするイオンビーム計測方法。

$$d_{yt} = (L_2 / L) d_{yf} + (L_1 / L) d_{yb}, \quad (\text{但し } L = L_1 + L_2)$$

【請求項4】

前記前段ビーム電流密度分布計測工程で求めたビーム電流密度分布から、前記前段ビーム制限シャッターの位置での前記イオンビームの前記  $y$  方向のビームサイズ  $d_{yf}$  を求める前段ビームサイズ算出工程と、

前記後段ビーム電流密度分布計測工程で求めたビーム電流密度分布から、前記後段ビーム制限シャッターの位置での前記イオンビームの前記  $y$  方向のビームサイズ  $d_{yb}$  を求める後段ビームサイズ算出工程と、

前記前段ビームサイズ算出工程で求めた前記ビームサイズ  $d_{yf}$ 、前記後段ビームサイズ算出工程で求めた前記ビームサイズ  $d_{yb}$  および前記前段ビーム制限シャッターと前記後段ビーム制限シャッターとの間の距離  $L$  を用いて、次式またはそれと数学的に等価な式に基づいて、前記イオンビームの前記  $y$  方向における発散角  $\alpha_{\max}$  を求める発散角算出工程とを更に行うことを特徴とする請求項1に記載のイオンビーム計測方法。

$$\alpha_{\max} = \tan^{-1} \{ (d_{yb} - d_{yf}) / 2L \}$$

【請求項5】

前記前段ビームサイズ算出工程で求めた前記ビームサイズ  $d_{yf}$ 、前記後段ビームサイズ算出工程で求めた前記ビームサイズ  $d_{yb}$ 、前記前段ビーム制限シャッターと前記後段ビーム制限シャッターとの間の距離  $L$ 、前記前段ビーム制限シャッターと前記ターゲットとの間の距離  $L_1$  および前記ターゲットと前記後段ビーム制限シャッターとの間の距離  $L_2$  を用いて、次式またはそれと数学的に等価な式に基づいて、前記ターゲット上でのイオンビームの前記  $y$  方向におけるビームサイズ  $d_{yt}$  を求めるビームサイズ算出工程とを更に行うことを特徴とする請求項4に記載のイオンビーム計測方法。

$$d_{yt} = (L_2 / L) d_{yf} + (L_1 / L) d_{yb}, \quad (\text{但し } L = L_1 + L_2)$$

【請求項6】

イオンビームを  $x$  方向に平行走査してターゲットに照射する装置であって、当該イオンビームのビーム電流を計測する複数の検出器が前記  $x$  方向にそれぞれ並設されて成る前段多点ファラデーおよび後段多点ファラデーをターゲットの上流側および下流側にそれぞれ有しているイオン注入装置において、

前記前段多点ファラデーの上流側近傍に設けられていて前記イオンビームを遮ることができるものであって前記  $x$  方向に平行な一辺を有する前段ビーム制限シャッターと、

この前段ビーム制限シャッターを前記  $x$  方向と直交する  $y$  方向に駆動する前段シャッター駆動装置と、

前記後段多点ファラデーの上流側近傍に設けられていて前記イオンビームを遮ることができるものであって前記  $x$  方向に平行な一辺を有する後段ビーム制限シャッターと、

この後段ビーム制限シャッターを前記  $y$  方向に駆動する後段シャッター駆動装置とを備えており、

更に、(a) 前記前段シャッター駆動装置によって前記前段ビーム制限シャッターを前記  $y$  方向に駆動しつつ、当該前段ビーム制限シャッターの前記一辺の外側を通過して前記前段多点ファラデーに入射するイオンビームのビーム電流の変化を計測して、前記前段ビーム制限シャッターの位置での前記イオンビームの前記  $y$  方向のビーム電流密度分布を求める前段ビーム電流密度分布計測処理と、(b) この前段ビーム電流密度分布計測処理で求めたビーム電流密度分布から、前記前段ビーム制限シャッターの位置での前記イオンビームの前記  $y$  方向の中心位置  $y_{cf}$  を求める前段中心位置算出処理と、(c) 前記後段シャ

ッター駆動装置によって前記後段ビーム制限シャッターを前記y方向に駆動しつつ、当該後段ビーム制限シャッターの前記一辺の外側を通過して前記後段多点ファラデーに入射するイオンビームのビーム電流の変化を計測して、前記後段ビーム制限シャッターの位置での前記イオンビームの前記y方向のビーム電流密度分布を求める後段ビーム電流密度分布計測処理と、(d)この後段ビーム電流密度分布計測処理で求めたビーム電流密度分布から、前記後段ビーム制限シャッターの位置での前記イオンビームの前記y方向の中心位置 $y_{cb}$ を求める後段中心位置算出処理と、(e)前記前段中心位置算出処理で求めた前記中心位置 $y_{cf}$ 、前記後段中心位置算出処理で求めた前記中心位置 $y_{cb}$ および前記前段ビーム制限シャッターと前記後段ビーム制限シャッターとの間の距離 $L$ を用いて、次式またはそれと数学的に等価な式に基づいて、前記イオンビームの前記y方向における角度偏差 $\theta_y$ を求める角度偏差算出処理とを行う制御装置を備えていることを特徴とするイオン注入装置。

$$\theta_y = \tan^{-1} \{ (y_{cb} - y_{cf}) / L \}$$

【請求項7】

イオンビームをx方向に平行走査してターゲットに照射する装置であって、当該イオンビームのビーム電流を計測する複数の検出器が前記x方向にそれぞれ並設されて成る前段多点ファラデーおよび後段多点ファラデーをターゲットの上流側および下流側にそれぞれ有しているイオン注入装置において、

前記前段多点ファラデーの上流側近傍に設けられていて前記イオンビームを遮ることができるものであって前記x方向に平行な一辺を有する前段ビーム制限シャッターと、

この前段ビーム制限シャッターを前記x方向と直交するy方向に駆動する前段シャッター駆動装置と、

前記後段多点ファラデーの上流側近傍に設けられていて前記イオンビームを遮ることができるものであって前記x方向に平行な一辺を有する後段ビーム制限シャッターと、

この後段ビーム制限シャッターを前記y方向に駆動する後段シャッター駆動装置とを備えており、

更に、(a)前記前段シャッター駆動装置によって前記前段ビーム制限シャッターを前記y方向に駆動しつつ、当該前段ビーム制限シャッターの前記一辺の外側を通過して前記前段多点ファラデーに入射するイオンビームのビーム電流の変化を計測して、前記前段ビーム制限シャッターの位置での前記イオンビームの前記y方向のビーム電流密度分布を求める前段ビーム電流密度分布計測処理と、(b)この前段ビーム電流密度分布計測処理で求めたビーム電流密度分布から、前記前段ビーム制限シャッターの位置での前記イオンビームの前記y方向のビームサイズ $d_{yf}$ を求める前段ビームサイズ算出処理と、(c)前記後段シャッター駆動装置によって前記後段ビーム制限シャッターを前記y方向に駆動しつつ、当該後段ビーム制限シャッターの前記一辺の外側を通過して前記後段多点ファラデーに入射するイオンビームのビーム電流の変化を計測して、前記後段ビーム制限シャッターの位置での前記イオンビームの前記y方向のビーム電流密度分布を求める後段ビーム電流密度分布計測処理と、(d)この後段ビーム電流密度分布計測処理で求めたビーム電流密度分布から、前記後段ビーム制限シャッターの位置での前記イオンビームの前記y方向のビームサイズ $d_{yb}$ を求める後段ビームサイズ算出処理と、(e)前記前段ビームサイズ算出処理で求めた前記ビームサイズ $d_{yf}$ 、前記後段ビームサイズ算出処理で求めた前記ビームサイズ $d_{yb}$ および前記前段ビーム制限シャッターと前記後段ビーム制限シャッターとの間の距離 $L$ を用いて、次式またはそれと数学的に等価な式に基づいて、前記イオンビームの前記y方向における発散角 $\alpha_{\max}$ を求める発散角算出処理とを行う制御装置を備えていることを特徴とするイオン注入装置。

$$\alpha_{\max} = \tan^{-1} \{ (d_{yb} - d_{yf}) / 2L \}$$

【請求項8】

イオンビームをx方向に平行走査してターゲットに照射する装置であって、当該イオンビームのビーム電流を計測する複数の検出器が前記x方向にそれぞれ並設されて成る前段多点ファラデーおよび後段多点ファラデーをターゲットの上流側および下流側にそれぞれ

有しているイオン注入装置において、

前記前段多点ファラデーの上流側近傍に設けられていて前記イオンビームを遮ることができるものであって前記 x 方向に平行な一辺を有する前段ビーム制限シャッターと、

この前段ビーム制限シャッターを前記 x 方向と直交する y 方向に駆動する前段シャッター駆動装置と、

前記後段多点ファラデーの上流側近傍に設けられていて前記イオンビームを遮ることができるものであって前記 x 方向に平行な一辺を有する後段ビーム制限シャッターと、

この後段ビーム制限シャッターを前記 y 方向に駆動する後段シャッター駆動装置とを備えており、

更に、(a) 前記前段シャッター駆動装置によって前記前段ビーム制限シャッターを前記 y 方向に駆動しつつ、当該前段ビーム制限シャッターの前記一辺の外側を通過して前記前段多点ファラデーに入射するイオンビームのビーム電流の変化を計測して、前記前段ビーム制限シャッターの位置での前記イオンビームの前記 y 方向のビーム電流密度分布を求める前段ビーム電流密度分布計測処理と、(b) この前段ビーム電流密度分布計測処理で求めたビーム電流密度分布から、前記前段ビーム制限シャッターの位置での前記イオンビームの前記 y 方向のビームサイズ  $d_{yf}$  を求める前段ビームサイズ算出処理と、(c) 前記後段シャッター駆動装置によって前記後段ビーム制限シャッターを前記 y 方向に駆動しつつ、当該後段ビーム制限シャッターの前記一辺の外側を通過して前記後段多点ファラデーに入射するイオンビームのビーム電流の変化を計測して、前記後段ビーム制限シャッターの位置での前記イオンビームの前記 y 方向のビーム電流密度分布を求める後段ビーム電流密度分布計測処理と、(d) この後段ビーム電流密度分布計測処理で求めたビーム電流密度分布から、前記後段ビーム制限シャッターの位置での前記イオンビームの前記 y 方向のビームサイズ  $d_{yb}$  を求める後段ビームサイズ算出処理と、(e) 前記前段ビームサイズ算出処理で求めた前記ビームサイズ  $d_{yf}$ 、前記後段ビームサイズ算出処理で求めた前記ビームサイズ  $d_{yb}$ 、前記前段ビーム制限シャッターと前記後段ビーム制限シャッターとの間の距離  $L$ 、前記前段ビーム制限シャッターと前記ターゲットとの間の距離  $L_1$  および前記ターゲットと前記後段ビーム制限シャッターとの間の距離  $L_2$  を用いて、次式またはそれと数学的に等価な式に基づいて、前記ターゲット上でのイオンビームの前記 y 方向におけるビームサイズ  $d_{yt}$  を求めるビームサイズ算出処理とを行う制御装置を備えていることを特徴とするイオン注入装置。

$$d_{yt} = (L_2 / L) d_{yf} + (L_1 / L) d_{yb}, \quad (\text{但し } L = L_1 + L_2)$$

#### 【請求項 9】

前記制御装置が、更に、(a) 前記前段ビーム電流密度分布計測処理で求めたビーム電流密度分布から、前記前段ビーム制限シャッターの位置での前記イオンビームの前記 y 方向のビームサイズ  $d_{yf}$  を求める前段ビームサイズ算出処理と、(b) 前記後段ビーム電流密度分布計測処理で求めたビーム電流密度分布から、前記後段ビーム制限シャッターの位置での前記イオンビームの前記 y 方向のビームサイズ  $d_{yb}$  を求める後段ビームサイズ算出処理と、(c) 前記前段ビームサイズ算出処理で求めた前記ビームサイズ  $d_{yf}$ 、前記後段ビームサイズ算出処理で求めた前記ビームサイズ  $d_{yb}$  および前記前段ビーム制限シャッターと前記後段ビーム制限シャッターとの間の距離  $L$  を用いて、次式またはそれと数学的に等価な式に基づいて、前記イオンビームの前記 y 方向における発散角  $\alpha_{\max}$  を求める発散角算出処理とを行うことを特徴とする請求項 6 に記載のイオン注入装置。

$$\alpha_{\max} = \tan^{-1} \{ (d_{yb} - d_{yf}) / 2L \}$$

#### 【請求項 10】

前記制御装置が、更に、前記前段ビームサイズ算出処理で求めた前記ビームサイズ  $d_{yf}$ 、前記後段ビームサイズ算出処理で求めた前記ビームサイズ  $d_{yb}$ 、前記前段ビーム制限シャッターと前記後段ビーム制限シャッターとの間の距離  $L$ 、前記前段ビーム制限シャッターと前記ターゲットとの間の距離  $L_1$  および前記ターゲットと前記後段ビーム制限シャッターとの間の距離  $L_2$  を用いて、次式またはそれと数学的に等価な式に基づいて、前記ターゲット上でのイオンビームの前記 y 方向におけるビームサイズ  $d_{yt}$  を求めるビームサイ



ズ算出処理を行うことを特徴とする請求項 9 に記載のイオン注入装置。

$$d_{yt} = (L_2 / L) d_{yf} + (L_1 / L) d_{yb}, \quad (\text{但し } L = L_1 + L_2)$$



【書類名】明細書

【発明の名称】イオンビーム計測方法およびイオン注入装置

【技術分野】

【0001】

この発明は、イオンビームを  $x$  方向に平行走査してターゲットに照射する方式のイオン注入装置において、前記  $x$  方向と直交する  $y$  方向のイオンビームの角度偏差、発散角およびビームサイズを計測するイオンビーム計測方法ならびに当該計測方法を制御装置を用いて行うことができるイオン注入装置に関する。

【背景技術】

【0002】

イオン注入技術は、昨今の半導体製造プロセス等においては、重要な位置を占めている。

【0003】

ターゲット、例えば半導体基板へのイオン注入においては、半導体基板の結晶軸に対する注入角（入射角）によって、注入深さ方向に特異な注入特性を示すことが知られており、これを防ぐ、またはこれを積極的に利用するような条件でのイオン注入処理を可能にすることが、通常、イオン注入技術に求められている。

【0004】

チャネリングと呼ばれる上記現象は、イオンの入射角が 0 度付近において特に入射角依存性が高いので、入射角が 0 度付近においてより高精度の入射角制御が要求されるけれども、その他の入射角においても、通常、高精度の入射角制御が要求される。

【0005】

このような要求にある程度応えることのできるイオン注入装置の一例が特許文献 1 に記載されている。この特許文献 1 に記載されているイオン注入装置と同様のイオン注入装置を図 1 に示す。

【0006】

このイオン注入装置は、イオンビーム 4 を射出するイオン源 2 と、このイオン源 2 からのイオンビームが入射され当該イオンビーム 4 から所望質量のイオンビーム 4 を分離して取り出す質量分離器 6 と、この質量分離器 6 からのイオンビーム 4 が入射され当該イオンビーム 4 を加速または減速する加減速器 8 と、この加減速器 8 からのイオンビーム 4 が入射され当該イオンビーム 4 から所望エネルギーのイオンビーム 4 を分離して取り出すエネルギー分離器 10 と、このエネルギー分離器 10 からのイオンビーム 4 が入射され当該イオンビーム 4 を  $x$  方向（例えば水平方向）に走査する走査器 12 と、この走査器 12 からのイオンビーム 4 が入射され当該イオンビーム 4 を曲げ戻して後述する  $z$  軸に平行になるように平行化するビーム平行化器 14 と、このビーム平行化器 14 からのイオンビーム 4 の照射領域内でターゲット（例えば半導体基板）16 を前記  $x$  方向と直交する  $y$  方向（例えば垂直方向）に機械的に往復走査（往復駆動）する、または実質的に  $y$  方向に機械的に往復走査（往復駆動）するターゲット駆動装置 20（図 7 も参照）とを備えている。

【0007】

ここで、前記  $x$  方向（換言すれば  $x$  軸）および  $y$  方向（換言すれば  $y$  軸）と直交する方向であって、ターゲット 16 に入射するイオンビーム 4 の設計上の軌道方向に前記  $z$  軸を取っている。

【0008】

質量分離器 6 は、例えば、磁界によってイオンビーム 4 の質量分離を行う質量分離電磁石である。加減速器 8 は、例えば、複数枚の電極を有していて静電界によってイオンビーム 4 の加減速を行う加減速管である。エネルギー分離器 10 は、例えば、磁界によってイオンビーム 4 のエネルギー分離を行うエネルギー分離電磁石である。走査器 12 は、例えば、磁界によってイオンビーム 4 の走査を行う走査電磁石または電界によってイオンビーム 4 の走査を行う走査電極である。ビーム平行化器 14 は、例えば、磁界によってイオンビーム 4 の平行化を行うビーム平行化電磁石である。ターゲット駆動装置 20 は、例えば

、図7も参照して、ターゲット16を保持するホルダ18を有しており、このホルダ18に保持されたターゲット16を、矢印22に示すように前記y方向または実質的にy方向に往復走査する。

#### 【0009】

上記構成によって、所望の質量および所望のエネルギーのイオンビーム4をx方向に平行走査しながらターゲット16に照射すると共に、このイオンビーム4に対して所定の角度で保持したターゲット16をy方向に機械的に往復走査して、ターゲット16の全面に均一にイオンビーム4を照射して均一にイオン注入を行うことができる。このように、イオンビーム4の電磁的な走査とターゲット16の機械的な走査とを併用する方式は、ハイブリッドスキャン方式と呼ばれる。

#### 【0010】

この場合、イオンビーム4のビームライン上の各機器は、例えば質量分離器6、エネルギー分離器10、走査器12およびビーム平行化器14は、理想的には、x方向にのみ一次元でイオンビームを偏向し、y方向にはイオンビーム4を偏向しないように設計されている。従って、イオンビーム4のx方向の平行度を精度良く制御することによって、ターゲット16の表面には一定の入射角でイオンビーム4が照射されることになる。

#### 【0011】

ここで、ターゲット16に対するイオンビーム4の入射角とは、ターゲット16とイオンビーム4との相対的な角度のことであり、具体的には、ターゲット16の表面に立てた垂線とイオンビーム4との成す角をいう。この入射角には、より詳しく言えば、図10Aに示す例のようなx方向の（即ちx-z平面内における）入射角 $\phi_x$ と、図10Bに示す例のようなy方向の（即ちy-z平面内における）入射角 $\phi_y$ とがある。17は前記垂線である。例えば、図7に示すターゲット16は、図10Bの例と同様に、y方向の入射角 $\phi_y$ が0度よりも大きくなるように保持されている場合の例である。

#### 【0012】

イオンビーム4のx方向の平行度とは、図2に示す例のように、走査かつ平行化されたイオンビーム4がx-z平面内において実際に辿る軌道と前記z軸方向との成す角 $\theta_x$ をいう。従って、例えば、走査かつ平行化されたイオンビーム4がz軸に完全に平行な軌道を辿る理想的な場合は $\theta_x = 0^\circ$ である。また、このx方向の平行度 $\theta_x$ と前記x方向の入射角 $\phi_x$ とは大いに関係している。

#### 【0013】

また、図3に示す例のように、走査かつ平行化されたイオンビーム4がy-z平面内において実際に辿る軌道とz軸方向との成す角を $\theta_y$ とし、これをこの明細書ではイオンビーム4のy方向の角度偏差と呼ぶ。従って、例えば、走査かつ平行化されたイオンビーム4がz軸に完全に平行な軌道を辿る理想的な場合は $\theta_y = 0^\circ$ である。また、このy方向の角度偏差 $\theta_y$ と前記y方向の入射角 $\phi_y$ とは大いに関係している。

#### 【0014】

一般的に、荷電粒子ビーム、ここではイオンビーム4を特徴づける量として、全ビーム電流の他に、(a) ビーム電流密度分布を持ったイオンビーム4の中心が辿る中心軌道、(b) 中心軌道に垂直な面内におけるビーム電流密度分布の広がりを出すビームサイズ、(c) イオンビーム4の中心軌道方向に対する各構成イオンの運動方向のずれを表す発散角、等がある。これらのより具体的な定義については、図4～図6を参照して後述する。

#### 【0015】

イオンビーム4をターゲット16に照射してイオン注入を行う場合、イオンビーム4の入射角として最も重要な要素が、上記(a)の中心軌道のターゲット16への入射角である。この入射角を所望の値に設定することにより、イオンビーム4を構成する大部分のイオンが平均として所望の入射角でターゲット16に入射することになる。但し、実際には、イオンビーム4を構成する各イオンがそれぞれ発散角を有しているので、各イオンの入射角は、上記中心軌道の入射角の周りに幾らかの幅をもって存在することになる。

## 【0016】

従って、イオンビーム4のより高精度の入射角制御が要求される場合、まずは、イオンビーム4の中心軌道の入射角の高精度な制御を可能にすることが重要であり、次いで、高精度の発散角制御が可能であることが望ましい、と言える。

## 【0017】

このような要求に一部応えることができる技術として、特許文献2には、イオンビームのビーム電流を計測する複数の検出器がイオンビームの走査方向（例えば前記x方向）にそれぞれ並設されて成る前段多点ファラデーおよび後段多点ファラデーを、ターゲットの上流側および下流側にそれぞれ設けておき、両多点ファラデーにおいて、走査中のイオンビームが同一時刻においてビーム走査方向のどの位置にあるかを測定し、その結果から、両多点ファラデーの間の空間におけるイオンビームのビーム走査方向の平行度（即ち、前記x方向の平行度 $\theta_x$ ）を測定する技術が記載されている。

## 【0018】

図7に記載している前段多点ファラデー24が前記前段多点ファラデーに相当し、後段多点ファラデー28が前記後段多点ファラデーに相当する。両多点ファラデー24、28は、それぞれ、前記複数の検出器（例えばファラデーカップ。図示省略）を有している。各検出器の前方には、図7の例では、スリット状の入口26、30がそれぞれ設けられている。

## 【0019】

このような前段多点ファラデー24および後段多点ファラデー28を用いて、特許文献2に記載された前記技術に従って、イオンビーム4のx方向の平行度 $\theta_x$ を測定することができる。更に、その測定情報に基づいて、特許文献2に記載された技術に従って、ビーム平行化器14の駆動電流または駆動電圧を制御することによって、イオンビーム4のx方向の平行度 $\theta_x$ の高精度な制御も可能である。それによって、x-z平面内におけるイオンビーム4の中心軌道をz軸方向に精度良く揃えて、イオンビーム4のx方向の入射角 $\phi_x$ を精度良く制御することができる。

## 【0020】

【特許文献1】特許第3358336号公報（段落0002、0003、図1）

【特許文献2】特許第2969788号公報（第6欄—第11欄、図1—図9）

## 【発明の開示】

## 【発明が解決しようとする課題】

## 【0021】

例えば半導体デバイスの更なる高性能化、高微細化等に伴い、より具体例を挙げれば急峻な注入境界を持つイオン注入等を実現することができるようになるように、イオン注入技術には、更なる高精度の入射角制御を可能にすることが求められる傾向にある。そのためには、従来は問題にされていなかった、イオンビームの走査方向（x方向）に垂直なy方向のイオンビーム4の入射角をも精度良く制御することが重要である。

## 【0022】

特に、半導体製造プロセスの微細化に伴って、イオン注入深さを浅くするために、低エネルギーのイオンビーム4を輸送してターゲット16に照射することが今後ますます重要になるけれども、イオンビーム4のエネルギーが低くなると、イオンビーム4を構成するイオン同士の電氣的な反発（これを空間電荷効果という）によって、イオンビーム4が強く発散角を持つ傾向になる。

## 【0023】

それゆえに、高精度の入射角制御を行うには、まずは、イオンビーム4の走査方向と垂直なy方向の角度偏差 $\theta_y$ 、および発散角の一方、好ましくは両方を計測してそれを監視することが重要である。

## 【0024】

また、例えば前述したようなハイブリッドスキャン方式のイオン注入装置の場合、通常、イオンビーム4のx方向の走査に比べてターゲット16のy方向の走査が低速度である

が、生産性を向上するためにy方向の走査速度を高速にしてゆくと、ターゲット16に対する注入の均一性は、イオンビーム4のy方向の分布幅（ビームサイズ）によって影響を受ける可能性が高い。特に、イオンビーム4のy方向のビームサイズが極端に小さくなると、注入の均一性を低下させるので、高い注入均一性を確保するためには、ターゲット16上でのイオンビーム4のy方向のビームサイズを計測して当該ビームサイズを監視することも望ましいことである。

#### 【0025】

しかしながら、上記イオンビーム4のy方向の角度偏差 $\theta_y$ 、発散角、ビームサイズを計測するために、イオンビーム4のx方向の平行度等を計測するために従来から設けられている前段多点ファラデーおよび後段多点ファラデーとは全く別個のファラデー計測系を新たに設けると、(a)計測系が増えて構造が複雑になりコストも大幅に上昇すると共に、(b)計測時に、イオンビーム4のビームラインに対して、x方向の計測系とy方向の計測系とを入れ換える作業を行わなければならない、この入れ換え作業に要する時間が余分な時間となり、生産性を低下させることになる。

#### 【0026】

そこでこの発明は、イオンビームの走査方向と垂直なy方向の角度偏差、発散角およびビームサイズの内の少なくとも一つを、好ましくは前の二つを、より好ましくは三つを、簡単な構成によって計測することができるイオンビーム計測方法を提供することを一つの目的としている。

#### 【0027】

また、上記イオンビーム計測方法を、制御装置を用いて行うことができるイオン注入装置を提供することを他の目的としている。

#### 【課題を解決するための手段】

#### 【0028】

この発明に係るイオンビーム計測方法およびイオン注入装置では、前記前段多点ファラデーおよび後段多点ファラデーを用いる。更に、前記前段多点ファラデーの上流側近傍に設けられていて前記イオンビームを遮ることができるものであって前記x方向に平行な一辺を有する前段ビーム制限シャッターと、この前段ビーム制限シャッターを前記x方向と直交するy方向に駆動する前段シャッター駆動装置と、前記後段多点ファラデーの上流側近傍に設けられていて前記イオンビームを遮ることができるものであって前記x方向に平行な一辺を有する後段ビーム制限シャッターと、この後段ビーム制限シャッターを前記y方向に駆動する後段シャッター駆動装置とを設けておく。

#### 【0029】

そして、この発明に係る第1のイオンビーム計測方法では、前記前段シャッター駆動装置によって前記前段ビーム制限シャッターを前記y方向に駆動しつつ、当該前段ビーム制限シャッターの前記一辺の外側を通過して前記前段多点ファラデーに入射するイオンビームのビーム電流の変化を計測して、前記前段ビーム制限シャッターの位置での前記イオンビームの前記y方向のビーム電流密度分布を求める前段ビーム電流密度分布計測工程と、この前段ビーム電流密度分布計測工程で求めたビーム電流密度分布から、前記前段ビーム制限シャッターの位置での前記イオンビームの前記y方向の中心位置 $y_{cf}$ を求める前段中心位置算出工程と、前記後段シャッター駆動装置によって前記後段ビーム制限シャッターを前記y方向に駆動しつつ、当該後段ビーム制限シャッターの前記一辺の外側を通過して前記後段多点ファラデーに入射するイオンビームのビーム電流の変化を計測して、前記後段ビーム制限シャッターの位置での前記イオンビームの前記y方向のビーム電流密度分布を求める後段ビーム電流密度分布計測工程と、この後段ビーム電流密度分布計測工程で求めたビーム電流密度分布から、前記後段ビーム制限シャッターの位置での前記イオンビームの前記y方向の中心位置 $y_{cb}$ を求める後段中心位置算出工程と、前記前段中心位置算出工程で求めた前記中心位置 $y_{cf}$ 、前記後段中心位置算出工程で求めた前記中心位置 $y_{cb}$ および前記前段ビーム制限シャッターと前記後段ビーム制限シャッターとの間の距離 $L$ を用いて、次の数1またはそれと数学的に等価な式に基づいて、前記イオンビームの前記y方

向における角度偏差  $\theta_y$  を求める角度偏差算出工程とを行う。

【0030】

[数1]

$$\theta_y = \tan^{-1} \{ (y_{cb} - y_{cf}) / L \}$$

【0031】

この発明に係る第2のイオンビーム計測方法では、前記前段シャッター駆動装置によって前記前段ビーム制限シャッターを前記 y 方向に駆動しつつ、当該前段ビーム制限シャッターの前記一辺の外側を通過して前記前段多点ファラデーに入射するイオンビームのビーム電流の変化を計測して、前記前段ビーム制限シャッターの位置での前記イオンビームの前記 y 方向のビーム電流密度分布を求める前段ビーム電流密度分布計測工程と、この前段ビーム電流密度分布計測工程で求めたビーム電流密度分布から、前記前段ビーム制限シャッターの位置での前記イオンビームの前記 y 方向のビームサイズ  $d_{yf}$  を求める前段ビームサイズ算出工程と、前記後段シャッター駆動装置によって前記後段ビーム制限シャッターを前記 y 方向に駆動しつつ、当該後段ビーム制限シャッターの前記一辺の外側を通過して前記後段多点ファラデーに入射するイオンビームのビーム電流の変化を計測して、前記後段ビーム制限シャッターの位置での前記イオンビームの前記 y 方向のビーム電流密度分布を求める後段ビーム電流密度分布計測工程と、この後段ビーム電流密度分布計測工程で求めたビーム電流密度分布から、前記後段ビーム制限シャッターの位置での前記イオンビームの前記 y 方向のビームサイズ  $d_{yb}$  を求める後段ビームサイズ算出工程と、前記前段ビームサイズ算出工程で求めた前記ビームサイズ  $d_{yf}$ 、前記後段ビームサイズ算出工程で求めた前記ビームサイズ  $d_{yb}$  および前記前段ビーム制限シャッターと前記後段ビーム制限シャッターとの間の距離  $L$  を用いて、次の数2またはそれと数学的に等価な式に基づいて、前記イオンビームの前記 y 方向における発散角  $\alpha_{\max}$  を求める発散角算出工程とを行う。

【0032】

[数2]

$$\alpha_{\max} = \tan^{-1} \{ (d_{yb} - d_{yf}) / 2L \}$$

【0033】

この発明に係る第3のイオンビーム計測方法では、前記前段シャッター駆動装置によって前記前段ビーム制限シャッターを前記 y 方向に駆動しつつ、当該前段ビーム制限シャッターの前記一辺の外側を通過して前記前段多点ファラデーに入射するイオンビームのビーム電流の変化を計測して、前記前段ビーム制限シャッターの位置での前記イオンビームの前記 y 方向のビーム電流密度分布を求める前段ビーム電流密度分布計測工程と、この前段ビーム電流密度分布計測工程で求めたビーム電流密度分布から、前記前段ビーム制限シャッターの位置での前記イオンビームの前記 y 方向のビームサイズ  $d_{yf}$  を求める前段ビームサイズ算出工程と、前記後段シャッター駆動装置によって前記後段ビーム制限シャッターを前記 y 方向に駆動しつつ、当該後段ビーム制限シャッターの前記一辺の外側を通過して前記後段多点ファラデーに入射するイオンビームのビーム電流の変化を計測して、前記後段ビーム制限シャッターの位置での前記イオンビームの前記 y 方向のビーム電流密度分布を求める後段ビーム電流密度分布計測工程と、この後段ビーム電流密度分布計測工程で求めたビーム電流密度分布から、前記後段ビーム制限シャッターの位置での前記イオンビームの前記 y 方向のビームサイズ  $d_{yb}$  を求める後段ビームサイズ算出工程と、前記前段ビームサイズ算出工程で求めた前記ビームサイズ  $d_{yf}$ 、前記後段ビームサイズ算出工程で求めた前記ビームサイズ  $d_{yb}$ 、前記前段ビーム制限シャッターと前記後段ビーム制限シャッターとの間の距離  $L$ 、前記前段ビーム制限シャッターと前記ターゲットとの間の距離  $L_1$  および前記ターゲットと前記後段ビーム制限シャッターとの間の距離  $L_2$  を用いて、次の数3またはそれと数学的に等価な式に基づいて、前記ターゲット上でのイオンビームの前記 y 方向におけるビームサイズ  $d_{yt}$  を求めるビームサイズ算出工程とを行う。

【0034】

[数3]

$$d_{yt} = (L_2 / L) d_{yf} + (L_1 / L) d_{yb}, \quad (\text{但し } L = L_1 + L_2)$$

## 【0035】

また、前記前段ビーム電流密度分布計測工程、前記前段中心位置算出工程、前記後段ビーム電流密度分布計測工程、前記後段中心位置算出工程、前記角度偏差算出工程、前記前段ビームサイズ算出工程、前記後段ビームサイズ算出工程および前記発散角算出工程を行っても良い。

## 【0036】

更に、前記前段ビーム電流密度分布計測工程、前記前段中心位置算出工程、前記後段ビーム電流密度分布計測工程、前記後段中心位置算出工程、前記角度偏差算出工程、前記前段ビームサイズ算出工程、前記後段ビームサイズ算出工程、前記発散角算出工程および前記ビームサイズ算出工程を行っても良い。

## 【0037】

この発明に係るイオン注入装置は、前記工程に相当する処理の内の所定のものを行う制御装置を備えている。

## 【発明の効果】

## 【0038】

請求項1または6に記載の発明によれば、イオンビームの走査方向と垂直な $y$ 方向の角度偏差 $\theta_y$ を計測することができる。しかもこの計測を、イオンビームの走査方向の平行度等を計測するために設けられている前段多点ファラデーおよび後段多点ファラデーを利用して行うので、新たにファラデー計測系を設ける必要がない。従って、簡素な構成によって上記計測を行うことができる。また、ビームラインに対して、 $x$ 方向の計測系と $y$ 方向の計測系とを入れ換える作業が不要であるので、その分、余分な時間が減り、生産性が向上する。

## 【0039】

請求項2または7に記載の発明によれば、イオンビームの走査方向と垂直な $y$ 方向の発散角 $\alpha_{\max}$ を計測することができる。しかもこの計測を、イオンビームの走査方向の平行度等を計測するために設けられている前段多点ファラデーおよび後段多点ファラデーを利用して行うので、新たにファラデー計測系を設ける必要がない。従って、簡素な構成によって上記計測を行うことができる。また、ビームラインに対して、 $x$ 方向の計測系と $y$ 方向の計測系とを入れ換える作業が不要であるので、その分、余分な時間が減り、生産性が向上する。

## 【0040】

請求項3または8に記載の発明によれば、ターゲット上でのイオンビームの $y$ 方向におけるビームサイズ $d_{yt}$ を計測することができる。しかもこの計測を、イオンビームの走査方向の平行度等を計測するために設けられている前段多点ファラデーおよび後段多点ファラデーを利用して行うので、新たにファラデー計測系を設ける必要がない。従って、簡素な構成によって上記計測を行うことができる。また、ビームラインに対して、 $x$ 方向の計測系と $y$ 方向の計測系とを入れ換える作業が不要であるので、その分、余分な時間が減り、生産性が向上する。

## 【0041】

請求項4または9に記載の発明によれば、前記 $y$ 方向の角度偏差 $\theta_y$ および前記 $y$ 方向の発散角 $\alpha_{\max}$ を、簡素な構成によって計測することができる。また、上記と同様の理由によって、生産性も向上する。

## 【0042】

請求項5または10に記載の発明によれば、前記 $y$ 方向の角度偏差 $\theta_y$ 、前記 $y$ 方向の発散角 $\alpha_{\max}$ および前記ターゲット上での $y$ 方向のビームサイズ $d_{yt}$ を、簡素な構成によって計測することができる。また、上記と同様の理由によって、生産性も向上する。

## 【発明を実施するための最良の形態】

## 【0043】

図7は、この発明に係るイオンビーム計測方法を実施するイオン注入装置の一実施形態の要部を示す図である。イオン注入装置全体の構成は、例えば、図1およびそれに関する

前記説明を参照するものとする。また、図 1 に示した例と同一または相当する部分には同一符号を付し、以下においては当該例との相違点を主に説明する。

#### 【0044】

このイオン注入装置は、イオンビーム 4 の進行方向である  $z$  軸上の位置に関して、ターゲット 16 の上流側の位置  $z_{ff}$  に前記前段多点ファラデー 24 を有しており、ターゲット 16 の下流側の位置  $z_{fb}$  に前記後段多点ファラデー 28 を有している。ターゲット 16 の  $z$  軸上の位置を  $z_t$  とする。ターゲット 16 が図 7 に示す例のように傾いている場合は、ターゲット 16 の中心の  $z$  軸上の位置を  $z_t$  とする。

#### 【0045】

前段多点ファラデー 24 の上流側の近傍の位置  $z_f$  に、前記  $x$  方向に平行走査されたイオンビーム 4 を遮ることができる前段ビーム制限シャッター 32 が設けられている。この前段ビーム制限シャッター 32 は、前記  $x$  方向に平行な一辺 34 を有している。この一辺 34 は、前記  $x$  方向と精密に平行に保つのが好ましい。前段ビーム制限シャッター 32 は、この例では  $x$  方向に長い長方形をしているが、それに限らない。また、前記一辺 34 は、この例では前段ビーム制限シャッター 32 の下辺であるが、上辺でも良い。

#### 【0046】

前段ビーム制限シャッター 32 を保持してそれを、矢印 38 に示すように、前記  $y$  方向に往復駆動する前段シャッター駆動装置 36 が設けられている。この前段シャッター駆動装置 36 は、この例では、前段ビーム制限シャッター 32 の  $y$  方向の位置を精密に制御する制御回路および前記一辺 34 の  $y$  方向の位置  $y_1$  を精密に計測して出力する位置センサー（いずれも図示省略）を有している。

#### 【0047】

このイオン注入装置は、更に、後段多点ファラデー 28 の上流側の近傍の位置  $z_b$  に、より具体的にはターゲット 16 よりも下流側であって後段多点ファラデー 28 の上流側近傍の位置  $z_b$  に、前記  $x$  方向に平行走査されたイオンビーム 4 を遮ることができる後段ビーム制限シャッター 42 が設けられている。この後段ビーム制限シャッター 42 は、前記  $x$  方向に平行な一辺 44 を有している。この一辺 44 は、前記  $x$  方向と精密に平行に保つのが好ましい。後段ビーム制限シャッター 42 は、この例では  $x$  方向に長い長方形をしているが、それに限らない。また、前記一辺 44 は、この例では後段ビーム制限シャッター 42 の下辺であるが、上辺でも良い。

#### 【0048】

後段ビーム制限シャッター 42 を保持してそれを、矢印 48 に示すように、前記  $y$  方向に往復駆動する後段シャッター駆動装置 46 が設けられている。この後段シャッター駆動装置 46 は、この例では、後段ビーム制限シャッター 42 の  $y$  方向の位置を精密に制御する制御回路および前記一辺 44 の  $y$  方向の位置  $y_1$  を精密に計測して出力する位置センサー（いずれも図示省略）を有している。

#### 【0049】

図 6 も参照して、 $z$  軸に沿う方向における前段ビーム制限シャッター 32 と後段ビーム制限シャッター 42 との間の距離、即ち位置  $z_f$  と位置  $z_b$  との間の距離を  $L$ 、前段ビーム制限シャッター 32 とターゲット 16 との間の距離、即ち位置  $z_f$  と位置  $z_t$  との間の距離を  $L_1$ 、ターゲット 16 と後段ビーム制限シャッター 42 との間の距離、即ち位置  $z_t$  と位置  $z_b$  との間の距離を  $L_2$  とする。従って、 $L = L_1 + L_2$  である。

#### 【0050】

この実施形態では、更に、後述する各処理を行う制御装置 50 を備えている。

#### 【0051】

制御装置 50 は、前段シャッター駆動装置 36、後段シャッター駆動装置 46 をそれぞれ制御して前段ビーム制限シャッター 32、後段ビーム制限シャッター 42 を前記のようにそれぞれ駆動させると共に、前段シャッター駆動装置 36、後段シャッター駆動装置 46 から前記位置  $y_1$  の情報をそれぞれ取り込む。更に、前段多点ファラデー 24、後段多点ファラデー 28 から、後述するビーム電流  $S_{f,i}(y)$ 、 $S_{b,i}(y)$  の情報をそれぞれ

取り込む。

【0052】

更に、制御装置 50 には、上記距離  $L$ 、 $L_1$  および  $L_2$  の情報が与えられる（例えば設定される）。但し、距離  $L$  の情報を与えずに、制御装置 50 内で  $L = L_1 + L_2$  の演算を行わせても良い。

【0053】

ここで、この明細書における、イオンビーム 4 の  $y$  方向の中心軌道、ビームサイズおよび発散角の定義について説明する。

【0054】

図 4 に、イオンビーム 4 の  $y$  方向のビーム電流密度  $j$  の分布  $j(y)$  の例を示す。一般的に、ビーム電流密度  $j(y)$  は必ずしも単純な形状になるとは限らないので、ここでは、図 4 に示されているような形状を例として取り上げる。このとき、ビーム電流密度分布  $j(y)$  の積分の中心位置を  $y_c$  とする。即ち、図 4 中にハッチングを付した上半分の面積  $S_a$  と下半分の面積  $S_b$  とが互いに等しくなる位置が中心位置  $y_c$  である。このイオンビーム 4 の中心位置  $y_c$  の軌道が、イオンビーム 4 の  $y$  方向の中心軌道である。

【0055】

上記中心位置  $y_c$  が、 $z$  軸に沿って所定の距離だけ離れた 2 点間で異なっている場合、具体的には距離  $L$  だけ離れた前記前段ビーム制限シャッター 32 の位置  $z_f$  と前記後段ビーム制限シャッター 42 の位置  $z_b$ （図 6、図 7 参照）との間で異なっている場合、イオンビーム 4 の中心軌道は  $y$  方向に角度偏差  $\theta_y$  を持っていることになる。この場合、前段ビーム制限シャッター 32 の位置  $z_f$  および後段ビーム制限シャッター 42 の位置  $z_b$  におけるイオンビーム 4 の中心位置  $y_c$  をそれぞれ  $y_{cf}$ 、 $y_{cb}$  とすると、角度偏差  $\theta_y$  は前記数 1 で表される。

【0056】

次に、イオンビーム 4 の  $y$  方向のビームサイズについて説明する。図 5 に示す例において、ビーム電流密度分布  $j(y)$  中のビーム電流  $j$  の最大値を  $j_p$  とし、この最大値  $j_p$  に対して十分に小さい割合、例えば 10% の値を  $j_d$  とする。そして、ビーム電流密度分布  $j(y)$  中の  $y$  方向における上下の最も外側に位置していてビーム電流  $j$  の値が上記値  $j_d$  を横切る 2 点間の距離を  $d_y$  とし、これをイオンビーム 4 の  $y$  方向のビームサイズとする。

【0057】

次に、イオンビーム 4 の  $y$  方向の発散角について説明する。図 6 には、前記前段ビーム制限シャッター 32 の位置  $z_f$  におけるビーム電流密度分布  $j_f(y)$  の例と、前記後段ビーム制限シャッター 42 の位置  $z_b$  におけるビーム電流密度分布  $j_b(y)$  の例が示されている。一般的に言って、ビーム電流密度分布  $j(y)$  はイオンビーム 4 の進行方向である  $z$  軸上の位置によって異なっており、従って上記ビームサイズ  $d_y$  も異なっている。これは、イオンビーム 4 を構成する個々のイオンの運動方向がイオンビーム 4 の中心軌道の方向と必ずしも一致していないことによる。ここでは、前段ビーム制限シャッター 32 の位置  $z_f$  での前記ビームサイズを  $d_{yf}$  とし、後段ビーム制限シャッター 42 の位置  $z_b$  での前記ビームサイズを  $d_{yb}$  とする。従って、 $d_{yf} < d_{yb}$  であればイオンビーム 4 は両位置  $z_f$ 、 $z_b$  間で  $y$  方向に発散しており、 $d_{yf} > d_{yb}$  であれば集束していることになる。この両位置  $z_f$ 、 $z_b$  間でのイオンビーム 4 の  $y$  方向の発散角を  $\alpha_{\max}$  とすると、この発散角  $\alpha_{\max}$  は前記数 2 で表される。

【0058】

また、ターゲット 16 上での  $y$  方向のビームサイズ  $d_{yt}$  は、前記数 3 で表される。

【0059】

次に、上記のように表される角度偏差  $\theta_y$ 、発散角  $\alpha_{\max}$  およびビームサイズ  $d_{yt}$  の計測方法について説明する。

【0060】

イオンビーム 4 は、この計測に先立って、例えば前記特許文献 2 に記載の技術またはそ



れと同様の技術に従って、 $x$ 方向の平行度  $\theta_x$  を所望の値に、例えば  $\theta_x \cong 0^\circ$  に調整しておくのが好ましい。

#### 【0061】

計測に際しては、図8に示すように、前段多点ファラデー24をイオンビーム4の経路上に位置させておいて、前段シャッター駆動装置36によって前段ビーム制限シャッター32を $y$ 方向に駆動しつつ、前段多点ファラデー24に入射するイオンビーム4のビーム電流を前段多点ファラデー24によって計測する。この前段ビーム制限シャッター32の駆動は、前段ビーム制限シャッター32がイオンビーム4を全く遮っていない状態から遮る状態への駆動でも良いけれども、ここでは、前段ビーム制限シャッター32がイオンビーム4を完全に遮っている状態から遮らない状態への駆動を例に説明する。その前段ビーム制限シャッター32の駆動方向を矢印39で示す。この場合、初めはイオンビーム4は前段ビーム制限シャッター32によって完全に遮られているため、前段多点ファラデー24にはイオンビーム4は全く入射しない。このときの前段ビーム制限シャッター32の前記一辺34の $y$ 座標位置を $y_0$ とする。

#### 【0062】

そして、前段ビーム制限シャッター32が、矢印39で示すように $y$ 方向に駆動されると、駆動が進むにつれて、前段ビーム制限シャッター32によって遮られていたイオンビーム4の一部が前記一辺34の外側を通過して徐々に前段多点ファラデー24に入射するようになる。ここで、イオンビーム4の少なくとも一部が前段多点ファラデー24に入射しているときの前段ビーム制限シャッター32の前記一辺34の $y$ 座標位置を $y_1$ とする。

#### 【0063】

今、前段多点ファラデー24の $x$ 方向における $i$ 番目の検出器（例えばファラデーカップ）に着目し、その中心の $x$ 座標位置を $x_i$ とする。このとき、前段ビーム制限シャッター32の位置 $z_f$ において、 $x$ 座標 $x_i$ での $y$ 方向の前記ビーム電流密度分布 $j_f(y)$ を表す関数を $j_{f,i}(y)$ とする。このとき、 $i$ 番目の検出器で計測されるビーム電流 $S_{f,i}(y_1)$ は、次の数4で表される。これを図示したのが図9である。ここでは、ビーム電流密度 $j_{f,i}$ は、 $y_0$ 以下ではゼロであるとしている。

#### 【0064】

##### 【数4】

$$S_{f,i}(y_1) = \int_{y_0}^{y_1} j_{f,i}(y) dy$$

#### 【0065】

従って、前段シャッター駆動装置36によって前段ビーム制限シャッター32を $y$ 方向に駆動しつつ、前段多点ファラデー24でビーム電流 $S_{f,i}(y)$ を計測し、かつその次式で表される変化率から、位置 $z_f$ 、 $x_i$ でのイオンビーム4の $y$ 方向のビーム電流密度分布 $j_{f,i}(y)$ を求めることができる。これが、前段ビーム電流密度分布計測工程であり、これを行う。

#### 【0066】

##### 【数5】

$$dS_{f,i}(y) / dy = j_{f,i}(y)$$

#### 【0067】

上記と同様の方法によって、後段多点ファラデー28、後段ビーム制限シャッター42および後段シャッター駆動装置46を用いて、位置 $z_b$ 、 $x_i$ でのイオンビーム4の $y$ 方向のビーム電流密度分布 $j_{b,i}(y)$ を求めることができる。これが、後段ビーム電流密度分布計測工程であり、これを行う。なお、この後段での計測時は、その計測の妨げにならないように、前段ビーム制限シャッター32、前段多点ファラデー24およびターゲット

ト16をイオンビーム4の経路から外しておく。この制御を制御装置50に行わせても良い。この場合、前段多点ファラデー24は、図示しない駆動装置を用いてイオンビーム4の経路から外すようにすれば良い。

【0068】

更に、上記のようにして求めたビーム電流密度分布  $j_{f,i}(y)$ 、 $j_{b,i}(y)$  から、前段ビーム制限シャッター32、後段ビーム制限シャッター42のそれぞれの位置  $z_f$ 、 $z_b$  でのイオンビーム4の  $y$  方向の中心位置  $y_{cf}$ 、 $y_{cb}$  をそれぞれ求める。イオンビーム4の  $y$  方向の中心位置の定義は、図4を参照して先に説明した。これが、前段中心位置算出工程および後段中心位置算出工程である。

【0069】

更に、上記のようにして求めた中心位置  $y_{cf}$ 、 $y_{cb}$  および前記距離  $L$  を用いて、前記数1またはそれと数学的に等価な式に基づいて、イオンビーム4の  $y$  方向の角度偏差  $\theta_y$  を求める。これが、角度偏差算出工程である。これによって、イオンビーム4の  $y$  方向における中心軌道の状況を知ることができる。

【0070】

また、この実施形態では、制御装置50は、前記前段ビーム電流密度分布計測工程と同じ内容の前段ビーム電流密度分布計測処理、前記後段ビーム電流密度分布計測工程と同じ内容の後段ビーム電流密度分布計測処理、前記前段中心位置算出工程と同じ内容の前段中心位置算出処理、前記後段中心位置算出工程と同じ内容の後段中心位置算出処理および前記角度偏差算出工程と同じ内容の角度偏差算出処理を行うことができる。

【0071】

更に、必要に応じて、上記のようにして求めたビーム電流密度分布  $j_{f,i}(y)$ 、 $j_{b,i}(y)$  から、前段ビーム制限シャッター32、後段ビーム制限シャッター42のそれぞれの位置  $z_f$ 、 $z_b$  でのイオンビーム4の  $y$  方向のビームサイズ  $d_{yf}$ 、 $d_{yb}$  をそれぞれ求める。イオンビーム4の  $y$  方向のビームサイズの定義は、図5および図6を参照して先に説明した。これが、前段ビームサイズ算出工程および後段ビームサイズ算出工程である。

【0072】

更に、必要に応じて、上記のようにして求めたビームサイズ  $d_{yf}$ 、 $d_{yb}$  および前記距離  $L$  を用いて、前記数2またはそれと数学的に等価な式に基づいて、イオンビーム4の  $y$  方向における発散角  $\alpha_{\max}$  を求める。この発散角  $\alpha_{\max}$  の定義は、先に図6を参照して説明した。これが、発散角算出工程である。

【0073】

更に、必要に応じて、上記のようにして求めたビームサイズ  $d_{yf}$ 、 $d_{yb}$ 、前記距離  $L$ 、 $L_1$  および  $L_2$  を用いて、前記数3またはそれと数学的に等価な式に基づいて、ターゲット16上でのイオンビーム4の  $y$  方向におけるビームサイズ  $d_{yt}$  (図6も参照) を求める。これが、ビームサイズ算出工程である。

【0074】

上記制御装置50に、必要に応じて更に、前記前段ビームサイズ算出工程と同じ内容の前段ビームサイズ算出処理、前記後段ビームサイズ算出工程と同じ内容の後段ビームサイズ算出処理、前記発散角算出工程と同じ内容の発散角算出処理および前記ビームサイズ算出工程と同じ内容のビームサイズ算出処理を行わせても良く、この実施形態では、制御装置50はこれらの処理をも行うことができる。

【0075】

なお、前段多点ファラデー24が  $n$  個 ( $n$  は2以上の整数) の検出器を  $x$  方向に有する場合、前記  $i$  は1から  $n$  までの任意のものである。後段多点ファラデー28においても同様である。従って、 $x$  方向における1から  $n$  までの内の任意の番目の検出器を用いて、当該検出器の位置において、上記と同様の計測を行うことができる。

【図面の簡単な説明】

【0076】

【図1】従来のイオン注入装置の一例を示す概略図である。

【図 2】 イオンビームの平行度  $\theta_x$  の例を示す図である。

【図 3】 イオンビームの y 方向の角度偏差  $\theta_y$  の例を示す図である。

【図 4】 イオンビームの y 方向のビーム電流密度分布  $j(y)$  の例を示す図である。

【図 5】 イオンビームの y 方向のビームサイズ  $d_y$  の例を示す図である。

【図 6】 イオンビームの y 方向の発散角  $\alpha_{max}$  の例を示す図である。

【図 7】 この発明に係るイオンビーム計測方法を実施するイオン注入装置の一実施形態の要部を示す図である。

【図 8】 前段ビーム制限シャッターの位置での y 方向のビーム電流密度分布を計測する方法の一例を示す図である。

【図 9】 前段ビーム制限シャッターの位置での y 方向のビーム電流密度分布の一例を示す図である。

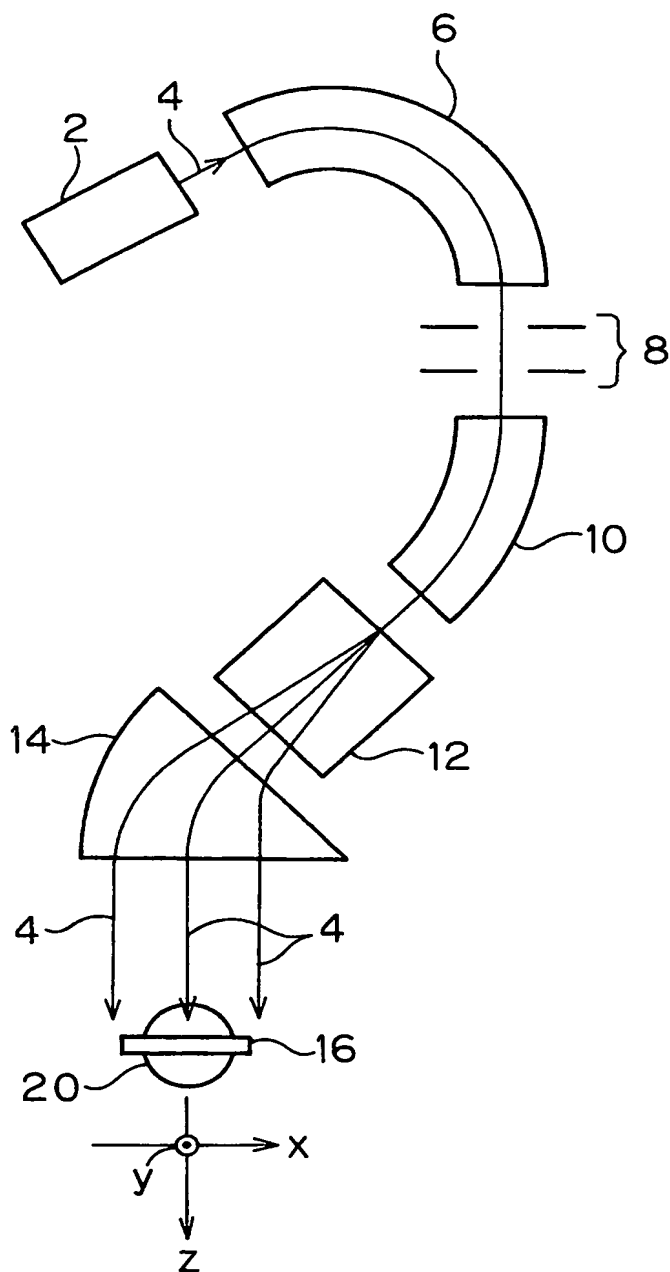
【図 10】 ターゲットへのイオンビームの入射角の例を示す図であり、(A) は x 方向の入射角  $\phi_x$  を示し、(B) は y 方向の入射角  $\phi_y$  を示す。

【符号の説明】

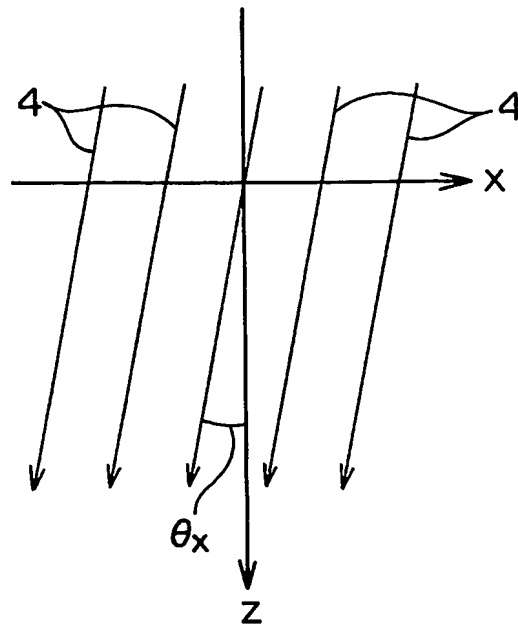
【0077】

- 4   イオンビーム
- 16   ターゲット
- 20   ターゲット駆動装置
- 24   前段多点ファラデー
- 28   後段多点ファラデー
- 32   前段ビーム制限シャッター
- 34   一辺
- 36   前段シャッター駆動装置
- 42   後段ビーム制限シャッター
- 44   一辺
- 46   後段シャッター駆動装置
- 50   制御装置

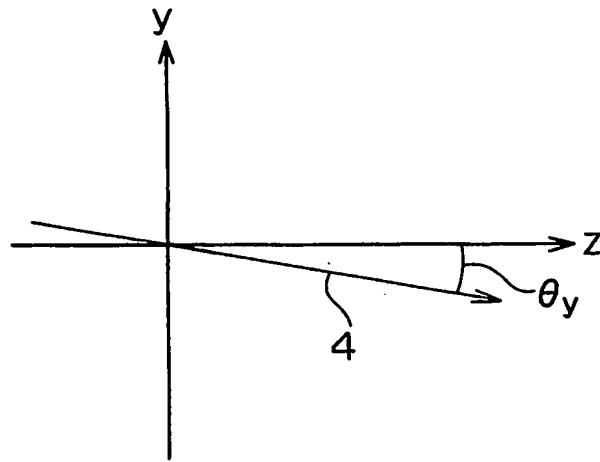
【書類名】 図面  
【図 1】



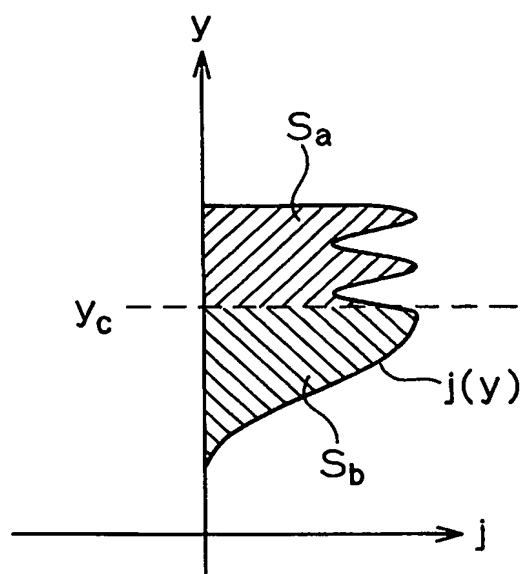
【図 2】



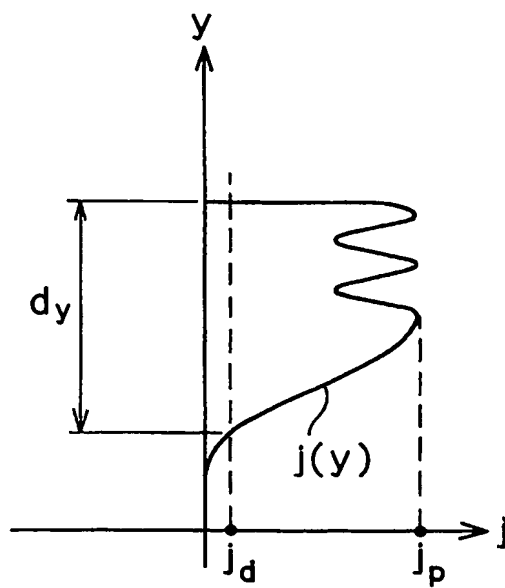
【図 3】



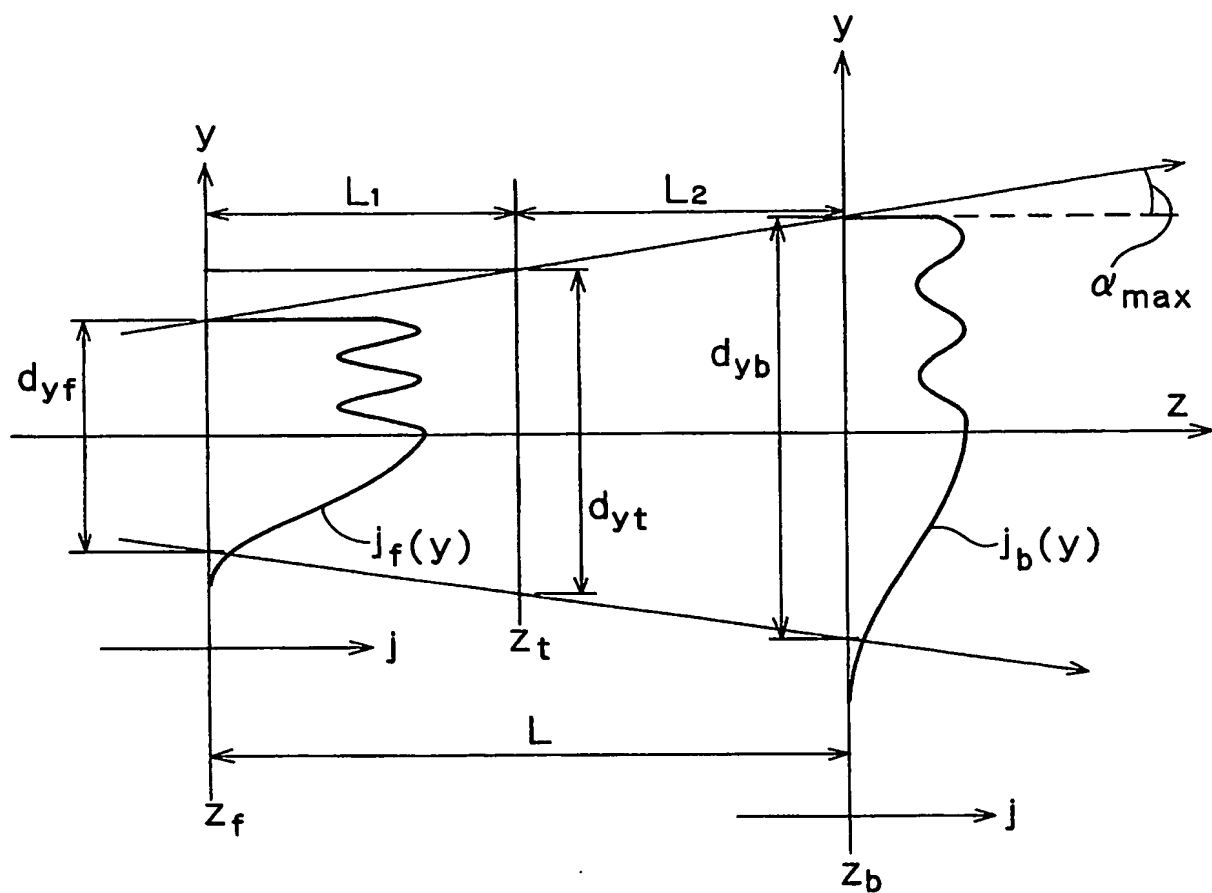
【図 4】



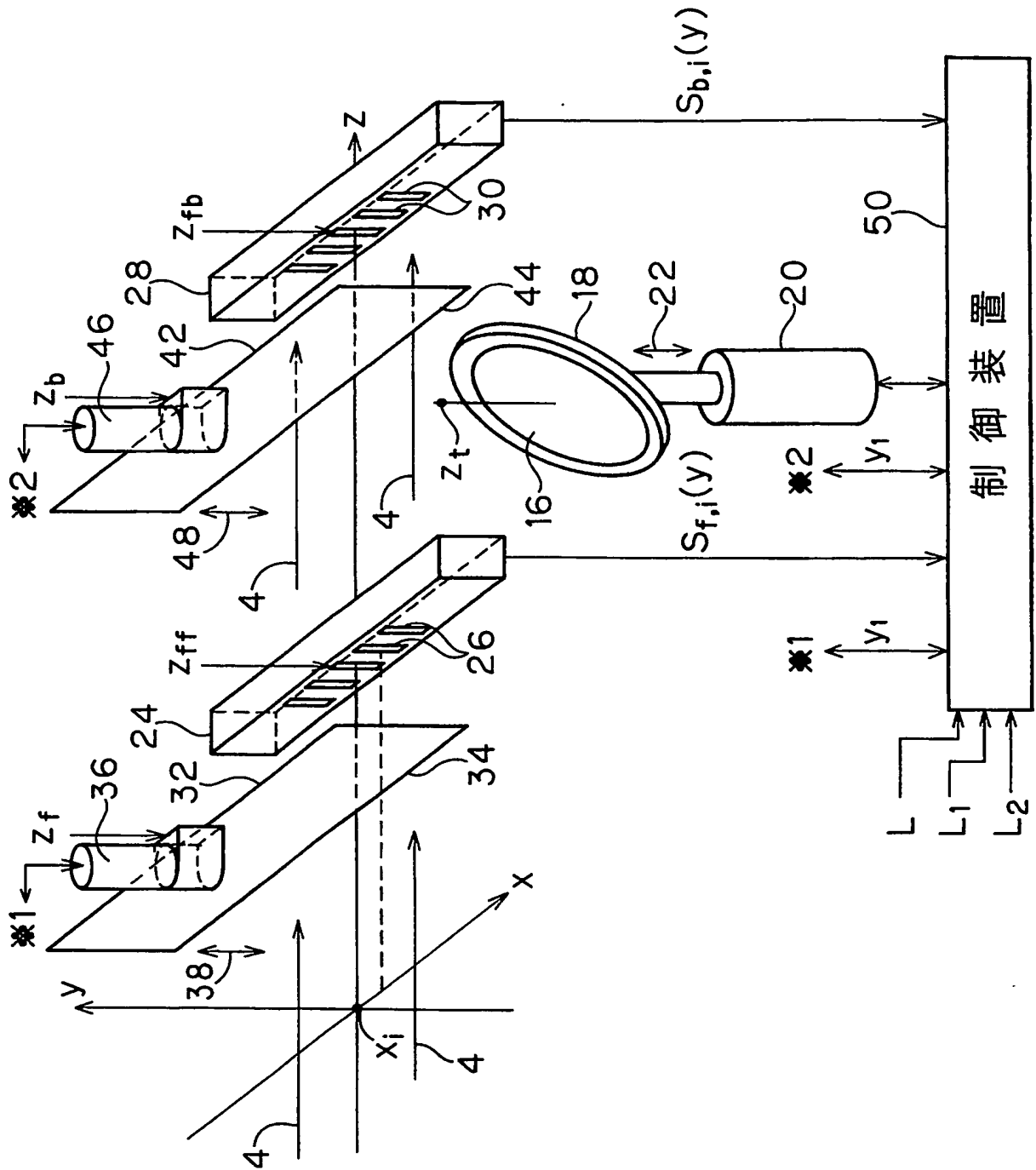
【図 5】



【図 6】

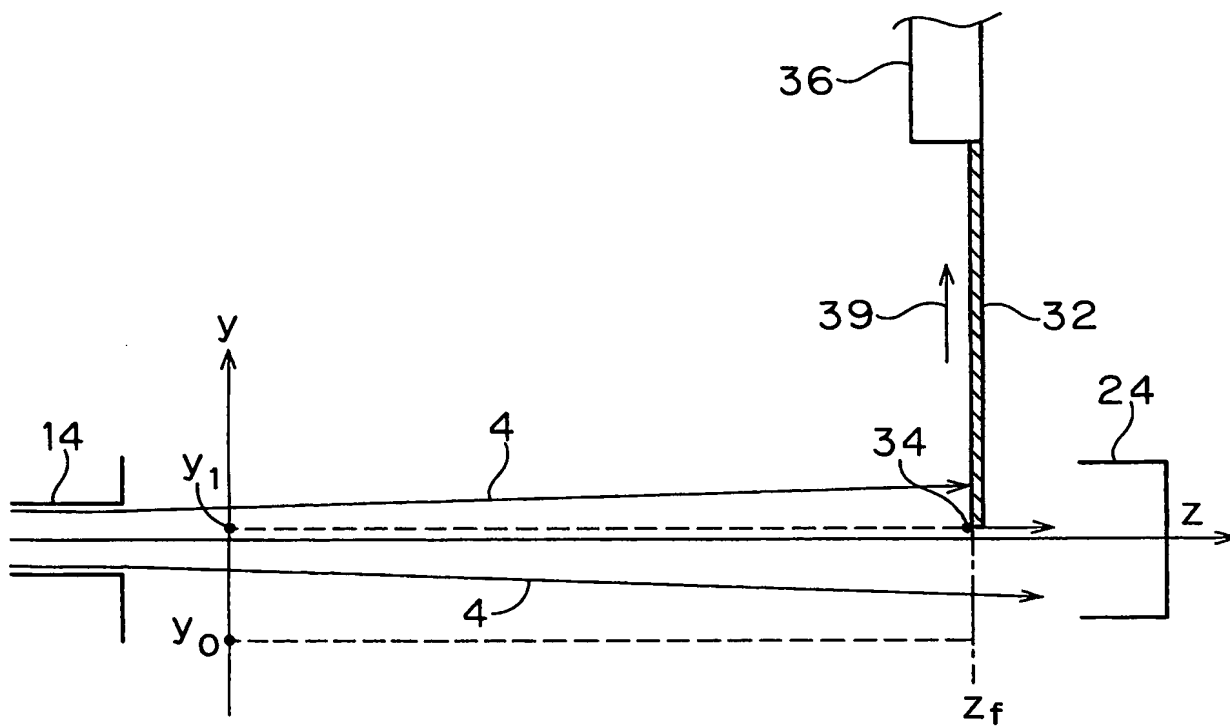


【図7】

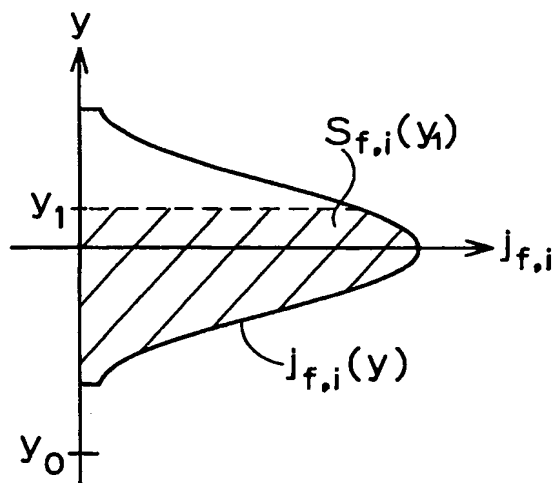




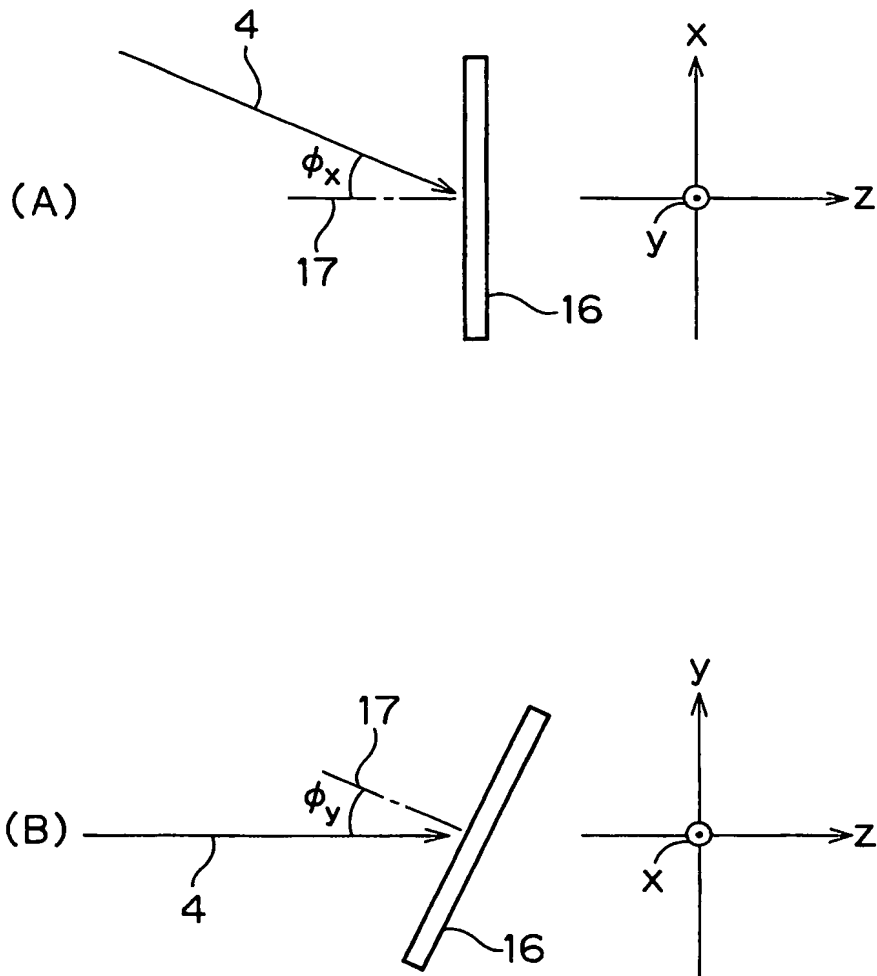
【圖 8】



【図 9】



【図 10】



**【書類名】 要約書****【要約】**

**【課題】** イオンビームの走査方向と垂直な y 方向の角度偏差、発散角およびビームサイズの内の少なくとも一つを簡単な構成によって計測することができるイオンビーム計測方法を提供する。

**【解決手段】** 前段シャッター駆動装置 36 によって前段ビーム制限シャッター 32 を y 方向に駆動しつつ、当該シャッター 32 の一辺 34 の外側を通過して前段多点ファラデー 24 に入射するイオンビーム 4 のビーム電流の変化を計測して、前段ビーム制限シャッター 32 の位置でのイオンビーム 4 の y 方向のビーム電流密度分布を計測する。かつ、後段シャッター駆動装置 46 によって後段ビーム制限シャッター 42 を y 方向に駆動しつつ、当該シャッター 42 の一辺 44 の外側を通過して後段多点ファラデー 28 に入射するイオンビーム 4 のビーム電流の変化を計測して、後段ビーム制限シャッター 42 の位置でのイオンビーム 4 の y 方向のビーム電流密度分布を計測する。そしてこの計測結果を用いて、イオンビーム 4 の y 方向の角度偏差、発散角およびビームサイズの内の少なくとも一つを計測する。

**【選択図】** 図 7

特願 2 0 0 4 - 0 0 1 0 0 6

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[ 3 0 2 0 5 4 8 6 6 ]

1. 変更年月日

2 0 0 2 年 9 月 1 7 日

[変更理由]

新規登録

住 所

京都府京都市南区久世殿城町 5 7 5 番地

氏 名

日新イオン機器株式会社

# Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP04/019833

International filing date: 28 December 2004 (28.12.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP  
Number: 2004-001006  
Filing date: 06 January 2004 (06.01.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 07 April 2005 (07.04.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland  
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse